

Аппроксимативно управляемую ЛНСВС можно с помощью гладких управлений из последовательности  $\{u_{i\sigma}(t, \mu)\}$  из любого начального состояния  $z_0$  перевести в сколь угодно малую  $\varepsilon$ -окрестность нулевого состояния за сколь угодно малое время, предшествующее моменту  $\sigma$ .

Определим матрицы

$$A_s(t) \triangleq A_1(t) - A_2(t)A_4^{-1}(t)A_3(t), \quad B_s(t) \triangleq B_1(t) - A_2(t)A_4^{-1}(t)B_2(t);$$

$n$ -вектор функции  $q_i^j(t)$ ,  $j = \overline{0, i}$ ,  $i = \overline{0, n-1}$  по рекуррентным формулам  $q_i^j(t) = (A^0(t)q_{i-1}^j(t) + A^1(t)q_{i-1}^{j-1}(t) - \dot{q}_{i-1}^j(t))$ ,  $q_0^0(t) = B^0(t)$ ,  $q_0^1(t) = B^1(t)$ ,  $q_i^j(t) = 0$  при  $j < 0$  или  $j > i + 1$ ;  $n_1$ -вектор функции  $q_{si}(t)$ ,  $i = \overline{0, n_1-1}$ , и  $n_2$ -вектор функции,  $q_{fi}(t)$ ,  $i = \overline{0, n_2-1}$ , по рекуррентным формулам  $q_{si}(t) = A_s(t)q_{s,i-1}(t) - \dot{q}_{s,i-1}(t)$ ,  $q_{s0}(t) = B_s(t)$ ,  $q_{si}(t) = 0$  при  $i < 0$ ,  $q_{fi}(t) = A_4(t)q_{f,i-1}(t)$ ,  $q_{f0}(t) = B_2(t)$ ,  $q_{fi}(t) = 0$  при  $i < 0$ .

Составим матрицы  $Q_s(t) = \{q_{si}(t), i = \overline{0, n_1-1}\}$ ,  $Q_f(t) = \{q_{fi}(t), i = \overline{0, n_2-1}\}$ .

**Теорема.** Если функции  $q_i^j(t)$ ,  $i = \overline{0, n-1}$ ,  $j = \overline{0, i}$ , непрерывно-дифференцируемы на  $T$ , то ЛНСВС (1) имеет класс  $n - 1$  для любого  $\mu > 0$ . Если к тому же  $\text{rank } Q_s(t) = n_1$ ,  $\text{rank } Q_f(t) = n_2$ , для любого  $t \in T$ , то ЛНСВС (1) аппроксимативно управляема на  $T$  при всех достаточно малых  $\mu \in (0, \mu^0]$ .

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Республики Беларусь в рамках государственной программы научных исследований Республики Беларусь на 2021–2025 гг. (шифр задания «Конвергенция 1.2.04»).

### Библиографические ссылки

1. Антосик П., Микусинский Я., Сикорский Р. Теория обобщенных функций. Секвенциальный подход. М., 1976.
2. Куржанский А. Б. О синтезе импульсных управлений и теории быстрых управлений // Тр. МИАН. 2010. Т. 268. С. 215–230.

## ЭКРАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ТОНКОСТЕННЫМ СФЕРИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ

Г. Ч. Шушкевич

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь  
*gsys@grsu.by*

Рассматривается аналитическое решение задачи экранирования высокочастотного электромагнитного поля тонкостенным сферическим экраном. Для аналитического решения поставленной задачи используются векторные сферические волновые функции.

Электромагнитная обстановка представляет собой совокупность электромагнитных полей в заданной области пространства, которая может влиять как на биологические объекты, так и на функционирование конкретных электронных устройства. Для

создания благоприятной электромагнитной обстановки производится электромагнитное экранирование [1]. Пусть в пространстве  $\mathbb{R}^3$  находится тонкостенный сферический экран толщиной  $\Delta$ , ограниченный сферическими поверхностями  $S_2(r = a_2)$  и  $S_1(r = a_1)$ ,  $a_2 > a_1$ . Обозначим внешнюю часть пространства по отношению к экрану через  $D_2(r > a_2)$ , внутреннюю – через  $D_1(r < a_1)$ . Тонкостенный экран выполнен из материала с электромагнитными параметрами  $\varepsilon$ ,  $\mu$ ,  $\gamma$ :  $\varepsilon$  – диэлектрическая проницаемость,  $\mu$  – абсолютная магнитная проницаемость,  $\gamma$  – удельная электрическая проводимость. Область  $D_m$ ,  $m = 1, 2$ , заполнена средой с электромагнитными параметрами  $\varepsilon_m$ ,  $\mu_m$ ,  $\gamma_m$ . В области  $D_2$  расположен источник электромагнитного поля – магнитный диполь Герца, колеблющийся с круговой частотой  $\omega$ .

Будем полагать, что на поверхностях  $S_1$  и  $S_2$  отсутствуют поверхностные токи и заряды. Для тонкостенных оболочек электромагнитное поле внутри оболочки не исследуется. Граничные условия рассматривают на срединной поверхности  $S_c$  [2, 3].

Обозначим через  $\vec{E}_e$ ,  $\vec{H}_e$  векторы напряженности электрического и магнитного полей диполя соответственно. В результате взаимодействия электромагнитного поля диполя с тонкостенным экраном образуются вторичные поля. Пусть  $\vec{E}_m$ ,  $\vec{H}_m$  – вторичные поля в области  $D_m$ ,  $m = 1, 2$ .

**Постановка задачи.** Требуется определить вторичные электромагнитные поля  $\vec{E}_2, \vec{H}_2 \in C^1(D_2) \cap C(\bar{D}_2)$ ,  $\vec{E}_1, \vec{H}_1 \in C(D_1) \cap C(\bar{D}_1)$ , которые удовлетворяют:

– уравнениям Максвелла [2]

$$\operatorname{rot} \vec{E}_m = i\omega \mu_m \vec{H}_m, \quad \operatorname{rot} \vec{H}_m = -i\omega \varepsilon_m \vec{E}_m, \quad m = 1, 2;$$

– граничным условиям на поверхности сферы  $S_c$

$$[\vec{n}, \vec{E}_e + \vec{E}_2 - \vec{E}_1]|_{S_c} = Z[\vec{n}, [\vec{H}_e + \vec{H}_2 + \vec{H}_1, \vec{n}]]|_{S_c},$$

$$[\vec{n}, \vec{H}_e + \vec{H}_2 - \vec{H}_1]|_{S_c} = G[\vec{n}, [\vec{E}_e + \vec{E}_2 + \vec{E}_1, \vec{n}]]|_{S_c},$$

$$Z = ik \operatorname{tg}(0.5k\Delta)/\omega\varepsilon, \quad G = ik \operatorname{tg}(0.5k\Delta)/\omega\mu, \quad k = \omega\sqrt{\varepsilon\mu},$$

где  $\vec{n}$  – единичная нормаль к поверхности  $S_c$ ;

– условию бесконечности

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r \left( \frac{\partial \vec{E}_2}{\partial r} - ik_2 \vec{E}_2 \right) = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} r \left( \frac{\partial \vec{H}_2}{\partial r} - ik_2 \vec{H}_2 \right) = 0.$$

Для решения задачи вторичные электромагнитные поля представим в виде суммы векторных сферических волновых функций [4]. После выполнения граничных условий получим систему линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов, входящих в представление вторичного поля.

### Библиографические ссылки

1. Кечиев Л. Н. Экранирование радиоэлектронной аппаратуры. М., 2019.
2. Аполлонский С. М. Моделирование и расчет электромагнитных полей в технических устройствах. Т. III. Расчеты электромагнитных полей в научных и инженерно-технических задачах. М., 2024.
3. Ерофеенко В. Т., Козловская И. С. Аналитическое моделирование в электродинамике. Мн., 2010.
4. Шушкевич Г. Ч. Рассеяние поля электрического диполя на многослойном биизотропном шаре // Всерос. конф. с междунар. участием (Теория управления и математическое моделирование). Ижевск, 2020. С. 347–348.